Копьев Петр Сергеевич

член отделения - Отделение физических наук РАН

член секции - Секция общей физики и астрономии ОНС ЕН

член отделения - Отделение физических наук РАН

член совета - Объединённый научный совет по естественным наукам (ОНС ЕН)

Звание: профессор

Академическое звание: член-корреспондент РАН

Ученая степень: доктор физико-математических наук

ps@kopjev.ioffe.ru

+7 (812) 297-36-20

Общая информация

Научные интересы

Физика и технология полупроводниковых наногетероструктур. Создание и исследование оптоэлектронных приборов на основе полупроводниковых наногетероструктур.

Научные публикации

- Молекулярно-пучковая эпитаксия соединений A3B5 и гетероструктур на их основе ФТП, т.22, вып.10, 1729- 1742,1988. П. С. Копьев, Н. Н. Леденцов.
- SCH lasers using short period superlattices Surf. Sci., v.228, 1990, P.S.Kop’ev
- Low threshold, large T0 injection laser emission from (InGa)As quantum dots, Electron. Lett., v.30, No17 1994, 1416-1417, N.Kirstaedter, N.N.Ledentsov, M.Grundmann, P.S.Kop’ev D.Bimberg, S.S.Ruvimov и др., всего 11 чел.
- Ultranarrow luminescence lines from single quantum dots. Phys. Rev. Lett., v.74, No20, 1995, 4043-4046, M.Grundmann, J.Christen, P.S.Kop’ev N.N.Ledentsov, V.M.Ustinov, J.Bohrer и др., всего 14 чел.
- Формирование вертикально совмещенных массивов напряженных квантовых точек InAs в матрице GaAs (100), ФТП т.30, вып.9,1996, 1682-1690, А. Е. Жуков, А. Ю. Егоров, П. С. Копьев, Н. Н. Леденцов, М. В. Максимов, А. Ф. Цацульников и др., всего 9 чел.
- Плазмонные эффекты в наноструктурах на основе In (Ga)N, УФН, т.179, 9, 2009, Шубина, ТВ; Иванов, СВ; Торопов, АА; Копьев, ПС
- Молекулярно-пучковая эпитаксия гетероструктур широкозонных соединений AIIBVI для низкопороговых лазеров с оптической и электронной накачкой ФТП, т.49, 3, 2015 Сорокин, СВ; Гронин, СВ; Седова, ИВ; Рахлин, МВ; Байдакова, МВ; Копьев, ПС; Вайнилович, АГ; Луценко, ЕВ; Яблонский, ГП; Гамов, НА; Жданова, ЕВ; Зверев, ММ; Рувимов, СС; Иванов, СВ
- Ultrabroad tuning range (100 nm) of external-cavity continuous-wave high-power semiconductor lasers based on a single InGaAs quantum well, 2019, Appl. Optics, v.58, 33 pp:

9089-9093 Podoskin, A; Golovin, V; Gavrina, P; Veselov, D; Zolotarev, V; Shamakhov, V; Nikolaev, D; Leshko, A; Slipchenko, S; Pikhtin, N; Kop`ev, P
- Ватт-амперные характеристики мощных импульсных полупроводниковых лазеров (1060 нм), работающих при повышенных (до 90 °C) температурах, 2021 Квант. электрон., т.51, 2, Гаврина, ПС; Подоскин, АА; Фомин, ЕВ; Веселов, ДА; Шамахов, ВВ; Слипченко, СО; Пихтин, НА; Копьев, ПС
- Tunnel-Coupled Laser Diode Microarray as a kW-Level 100-ns Pulsed Optical Power Source (lambda=910 nm), 2022, IEEE Photonics Technol. Lett., v.34, 1 pp: 35-38,Slipchenko, SO; Podoskin, AA; Veselov, DA; Strelets, VA; Rudova, NA; Pikhtin, NA; Bagaev, TA; Ladugin, MA; Marmalyuk, AA; Kop`ev, PS

Премии и награды

- Премия Ленинского комсомола — 1976 год.
- Орден Почета — 1999 год.
- Государственная премия РФ в области науки и техники — 2001 год.
- Орден Дружбы — 2010 год.
- Почетное звание «Почетный работник науки и высоких технологий Российской Федерации» — 2021 год.

Место работы и должность

Главный научный сотрудник, Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе РАН